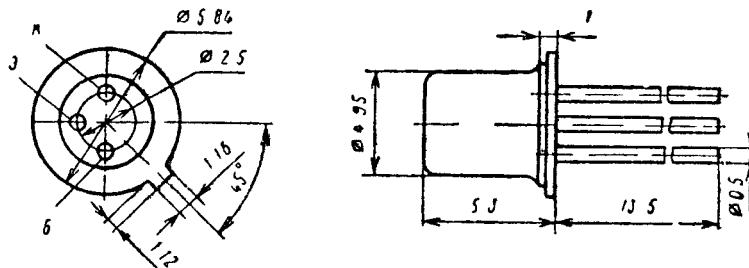


КТ501 (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М)

Транзисторы кремниевые эпитаксиально планарные структуры *p-n-p* усиительные. Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, операционных, дифференциальных и импульсных усилителях, преобразователях. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 0,6 г.

КТ501(А М)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ:
при $U_{ceo} = 1$ В $I_e = 30$ мА.

КТ501Ж, КТ501И, КТ501К	45 В
КТ501Л, КТ501М	60 В
Постоянное напряжение база — эмиттер:		
при $T = -60\dots+125$ °С для КТ501А, КТ501Б, КТ501В,		
КТ501Г, КТ501Д, КТ501Е		10 В
при $T = +25\dots+125$ °С для КТ501Ж, КТ501И, КТ501К,		
КТ501Л, КТ501М	20 В
Постоянный ток коллектора	0,3 А
Импульсный ток коллектора	0,5 А
Постоянный ток базы	0,1 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T = -60\dots+35$ °С	0,35 Вт
Temperatura <i>p-n</i> перехода	+150 °C
Temperatura окружающей среды	-60\dots+125 °C

При включении транзистора в цепь, находящуюся под напряжением, базовый контакт присоединяется первым и отключается последним.

Расстояние от места изгиба до корпуса транзистора не менее 3 мм с радиусом закругления 1,5..2 мм. Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора.

корпуса транзистора.

Постоянные напряжения коллектор — база и коллектор — эмиттер при $R_{cb} \leqslant 10$ кОм, $T = +25\dots+125$ °С:

КТ501А, КТ501Б, КТ501В	15 В
КТ501Г, КТ501Д, КТ501Е	30 В

КТ501Ж, КТ501И, КТ501К	45 В
КТ501Л, КТ501М	60 В
Постоянное напряжение база — эмиттер:		
при $T = -60\dots+125$ °С для КТ501А, КТ501Б, КТ501В,		
КТ501Г, КТ501Д, КТ501Е		10 В
при $T = +25\dots+125$ °С для КТ501Ж, КТ501И, КТ501К,		
КТ501Л, КТ501М	20 В
Постоянный ток коллектора	0,3 А
Импульсный ток коллектора	0,5 А
Постоянный ток базы	0,1 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T = -60\dots+35$ °С	0,35 Вт
Temperatura <i>p-n</i> перехода	+150 °C
Temperatura окружающей среды	-60\dots+125 °C

При включении транзистора в цепь, находящуюся под напряжением, базовый kontakt присоединяется первым и отключается последним.

Расстояние от места изгиба до корпуса транзистора не менее 3 мм с радиусом закругления 1,5..2 мм. Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора.